

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型 名	社 名	用 途	構 造	最大 定 格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)										外 形	備 考				
				V_{CBO}	V_{EBO}	I_C	P_C	T_j	I_{CBO} 最大値	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{FE}	h_{FE}^*	h_{FE}	h_{FE}^*	h_{FE}			f_{β}	C_{ob}	$r_{bb'}$	$r_{bb'}$
				(V)	(V)	(mA)	(mW)	($^{\circ}\text{C}$)	(μA)	$V_{CE}(\text{V})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$	$I_E(\text{mA})$	h_{FE}	(Ω)	($\times 10^{-4}$)	(μS)	(Mc)			(pF)	(Ω)	(Ω)	
1	2	3	4	5					6	7		8		9				10	11	12				

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{cso} MAXIMUM VALUE AND V_{ce} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{cso})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{ce} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

- 9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF $h_{ie}(\text{real})$
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 気 的 特 性 (T _a = 25℃)														外 形	備 考
				V _{CE0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (℃)	I _{CBO} 最大値 (μA)	V _{CB} (V)	直 流 又 は バ ル ス h _{FE} V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μS)	f _{αb} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb} h _{ie} (real)* (Ω)			
2SA1043	富士通	SW	Si. EP	~120	-5	-30A	150W (T _c =25℃)	175	-50	-120	100	-5	-3A	-10	2A			60 *	1000		299	2SC2433 とコンプリ		
" 1044	"	"	"	-70	-5	-30A	150W (T _c =25℃)	175	-50	-70	100	-5	-3A	-10	2A			60 *	1000		299	2SC2434 とコンプリ		
" 1045	"	"	"	-100	-5	-10A	100W (T _c =25℃)	175	-50	-100	3000	-3	-2A								102	シリコン 2SC2435 とコンプリ		
★ " 1046	"	"	"	-100	-5	-15A	100W (T _c =25℃)	175	-50	-100	3000	-3	-3A								102	シリコン 2SC2436 とコンプリ		
" 1047	三 洋	PA	"	-180	-5	-80	1 W	150	-1	-120	60~320	-5	-10	-10	10			130 *	3.2		296	2SC2441 とコンプリ		
" 1048	東 芝	AF	Si. E	-50	-5	-150	200	125	-0.1	-50	70~400	-6	-2	-10	1	NF = 1 dB (-6V, 0.1mA, 1kHz)			>80 *	4		287	2SC2458 とコンプリ	
" 1049	"	"	"	-120	-5	-100	200	125	-0.1	-120	200~700	-6	-2	-6	1	NF = 1 dB (-6V, 0.1mA, 1kHz)			100 *	4		287	2SC2459 とコンプリ	
" 1050	"	PA	"	-140	-5	-12A	100W (T _c =25℃)	150	-10	-140	55~240	-5	-1 A	-10	1 A			70 *	220	2 *	102	2SC2460 とコンプリ		
" 1051	"	"	"	-150	-5	-15A	150W (T _c =25℃)	150	-10	-150	55~240	-5	-1 A	-10	1 A			60 *	350	2 *	102	2SC2460 とコンプリ		
" 1052	日 立	AF	"	-30	-5	-100	150	125	-0.5	-20	100~500	-12	-2	-12	2			280 *	3.3		176			
" 1053	日 電	SW	"	-40	-5	-200	600	150	-0.1	-30	150	-1	-10			t _{on} < 70nS, t _{off} < 300nS t _{sig} < 225nS						138D		
" 1054	"	"	"	-60	-5	-600	600	150	-0.02	-50	200	-10	-150			t _{on} < 35nS, t _{off} < 255nS t _{sig} < 225nS						138D		
" 1055	"	"	"	-25	-4	-200	600	150	-0.05	-20	150	-1	-2			t _{on} < 70nS, t _{off} < 300nS t _{sig} < 225nS						138D		
" 1056	"	"	"	-40	-5	-600	600	150	-0.1	-35	150	-2	-150			t _{on} < 35nS, t _{off} < 255nS t _{sig} < 225nS						138D		
" 1057																								
" 1058																								
" 1059																								
" 1060	松 下	PA	Si. EP	-80	-5	-5A	60W (T _c =25℃)	150	-50	-80	90	-5	-1A	-5	500			20 *	170	10	152			
" 1061	"	"	"	-100	-5	-6A	70W (T _c =25℃)	150	-50	-100	90	-5	-1A	-5	500			20 *	240	10	152			
" 1062	"	"	"	-120	-5	-7A	80W (T _c =25℃)	150	-50	-120	90	-5	-1A	-5	500			20 *	290	10	152			
★ " 1063	"	"	"	-150	-5	-6A	80W (T _c =25℃)	150			40~280	-5	-2A	-10	500			50 *			102	2SC2487 とコンプリ		
" 1064	"	"	"	-150	-5	-8A	100W (T _c =25℃)	150			40~280	-5	-2A	-10	500			50 *			102	2SC2488 とコンプリ		
" 1065	"	"	"	-150	-5	-10A	120W (T _c =25℃)	150			40~280	-5	-2A	-10	500			50 *			102	2SC2489 とコンプリ		
" 1066	ソニー	LN	Si. EP _a	-70	-5	-200	500	120	-0.1	-50	95~420	-3	-10	-10	10			120 *	13		138	2SC2014 とコンプリ		
" 1067	サンケン	PA	Si. EP	-120	-5	-10A	100W (T _c =25℃)	150	-100	-120	60	-4	3A	-12	500			50 *	140	40	102			
" 1068	"	"	"	-150	-5	-10A	100W (T _c =25℃)	150	-100	-150	60	-4	-3A	-12	500			50 *	140	40	102			
" 1069	日 電	SW	Si. E	-80	-12	-5A	30W (T _c =25℃)	150	-10	-60	40~200	-5	-3A			t _{on} < 0.5μS, t _f < 0.5μS t _{sig} < 1.5μS						268	2SC2516 とコンプリ	
" 1070																								
" 1071																								
" 1072	富士通	PA	Si. P	-120	-5	-12A	120W (T _c =25℃)	150	-50	-120	110	-5	-1 A	-10	1 A			60 *	300	1.5 *	102	2SC2522 とコンプリ		